

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примеч.			
		<u>Диоды</u>							
VD2, VD3		15SQ045 (Dongguan YFW, Кумаї)			2				
VD1		1N4002 (Diotec Semiconductor, Германия)			1				
		<u>Конденсаторы</u>							
C4		K10-17Б 1000нФ 50В ±5% (Murata Electronics, Япония)			1				
C1		K10-17Б 220нФ 50В ±5% (Murata Electronics, Япония)			1				
C7		K73-17 0,68мкФ 250В ±5%			1				
		(Кузнецкий завод конденсаторов, Россия)							
C6, C8		K50-35 2200мкФ 35В ±20% (JB Capacitors, Гонконг)			2				
C2, C5		K50-35 мини 47мкФ 50В ±20% (JB Capacitors, Гонконг)			2				
C3		K50-35 100мкФ 63В ±20% (JB Capacitors, Гонконг)							
		<u>Разъёмы</u>							
XS1		Гнездо стерео 3,5мм ST-025			1				
		(Dragon City Industries, Кумаї)							
XP1		Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-03P (Degson, Кумаї)			1				
XP2		Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-02P (Degson, Кумаї)			1				
		<u>Резисторы</u>							
R14, R15		CF-25 0,25Вт 4.7кОм ±5%			2				
R3, R5		CF-25 0,25Вт 6800м ±5%			2				
R12, R13		CF-25 0,25Вт 3кОм ±5%			2				
R11		CF-25 0,25Вт 15кОм ±5%			1				
					ИЧ4.11.03.03.23.05.52.04.001 ПЭЗ				
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.	Бакулевский								
Пров.	Семенцов С. Г.								
Н. контр.					Усилитель низкой частоты Перечень элементов		Лит.	Лист	Листов
Утв.								1	2
							МГТУ им Н.Э. Баумана Кафедра ИЧ4 Группа ИЧ4 – 52Б		

[illegible]